

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 55-128816

(43) Date of publication 6.10.1980

(51) Int. Cl. H01G 9/05

(21) Application number: 54-36534 (71) Applicant: MARCON ELECTRONICS
CO., LTD.

(22) Date of filing: 27.3.1979 (72) Inventor: JUNICHI MUROI

TANTALUM SOLID ELECTROLYTIC CAPACITOR

Scope of claim

(1) A tantalum solid electrolytic capacitor produced by the process of sintering and conducting formation of tantalum powder, penetrating the powder with a material solution of a semiconductor layer and calcinating the powder wherein the ratio of the pores having a diameter of 2 μ m or more is 0.68 or more in the accumulated porosity of a capacitor element after calcinating in the capacitor.

(2) The tantalum solid electrolytic capacitor as claimed in claim 1, wherein the tantalum powder mainly comprises flat or agglomerated particles.

⑨ 日本国特許庁 (JP)
⑩ 公開特許公報 (A)

⑪ 特許出願公開

昭55-128816

⑫ Int. Cl.³
H 01 G 9/05

識別記号

庁内整理番号
7924-5E

⑬ 公開 昭和55年(1980)10月6日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 4 頁)

⑭ タンタル固体電解コンデンサ

長井市宮1560番地マルコン電子
株式会社内

⑮ 特 願 昭54-36534

⑯ 出 願 人 マルコン電子株式会社

⑰ 出 願 昭54(1979)3月27日

長井市宮1560番地

⑱ 発 明 者 室井純一

明 論 書

1. 発明の名称

タンタル固体電解コンデンサ

2. 特許請求の範囲

- (1) タンタル粉粒を焼結し化成-半導体層膜被食液で浸漬を行なうコンデンサにおいて、焼結後のコンデンサ素子が有する無極空間率のうち2 μ m以上の空孔の占める比率が0.68以上であることを特徴とするタンタル固体電解コンデンサ。
- (2) タンタル粉粒の形状が扁平粒を主としたものまたは板条状を主としたものからなることを特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載のタンタル固体電解コンデンサ。

3. 発明の詳細な説明

本発明はタンタル粉末を成形したのち焼結するタンタル固体電解コンデンサに関し、特に成形後焼結したコンデンサ素子への半導体層膜被食液例えば硫酸マンガン溶液の含浸性を高め静電容量が大で、かつ所望の特性を得ることのできるタンタル固体電解コンデンサを提供するものである。

従来既知のタンタル固体電解コンデンサは高純度のタンタル粉末を例えば円筒形にプレス成形しこれを真空度 10^{-6} ~ 10^{-8} Torr、温度1500~2000℃で焼結してコンデンサ素子を得ていたが大きな静電容量を得るためには単にコンデンサ素子が多孔であればよいと考えられていた。しかしながら近年タンタル粉末の形状についての研究も進められ例えば特公昭52-41486号公報に記載のように扁平粒を使用して比較密着な静電容量の増大を図ることも検討されてきた。

本発明はタンタル固体電解コンデンサにおいてタンタル粉粒の形状に無関係に半導体層膜被食液の含浸性について実験し、焼結後のコンデンサ素子が多孔であるとともに半導体層膜被食液を容易に含浸せしめることのできる空孔性すなわち焼結により生ずる粉粒間の空隙をより多く得ることによつて静電容量が大で、かつ所望のレベルの特性のタンタル固体電解コンデンサを得ることを目的としたものである。

以下実施例により説明する。

(1)

(2)

実 例 1

厚さ3mmのタンタル板に密着な貫通孔を穿ち、真空度 10^{-5} Torr、温度1600°C中で30分間加熱し前記の密着な貫通孔がそれぞれ1μm、2μm、3μm……7μmとなるものを得た。そしてこれらの貫通孔を30V化成-納銀-マンガン含浸-反応を6回くり返し、この時得られた貫通孔による静電容量の比と貫通孔径との関係を示したのが図1図である。これによれば貫通孔径が4μm以上では全く同じ静電容量値を示すのに対し、これを4μmを100とした場合3μmでは95、2μmでは90と若干低下し1μmでは50と急激な低下を示す。これは酸化成分および納銀-マンガンの含浸が行なわれない貫通孔部がありその比が第1図に示したとおりであると言うことができる。したがって理想的には4μm以上の貫通孔であればもつとも有効に利用できるわけであるが、実際にはタンタル粉粒をプレス成形したのち焼結してコンデンサ素子を得るのであるから4μm未満の空孔を容れとすることは不可能である。よって静電容量が急激に低

(5)

それぞれの空孔部が有する空隙率を数値で表わしたものである。この実験において焼結後の密度が $5g/cm^3$ の場合焼結後においてコンデンサ素子の反り、割くずれなどの変形を生じて使用に耐えず、また $10g/cm^3$ の場合には高硬度となるために全体として著しく空隙率の低下するほか、空隙率に占める2μm以上の空孔径の比率が低下し静電容量的に不利になる。したがって第1図に示したように静電容量が急激な低下を示す空孔径2μm未満の空孔を全空隙の中でより少なくし3μm以上の空孔をより多くすることが肝要となる。第2図に示した累積空隙率から全空隙中に占める2μm以上の空孔の比率を密度との関係において示したのが図1図である。

第 1 表

	密度 (g/cm^3)	累積空隙率 (%)	2μm以上の空孔 (%)	比率
本発明1	6	68	40	0.68
2	7	50	34	0.68
3	8	32	26	0.81
4	9	22	19.5	0.89
参考例1	10	13	6.5	0.50

(5)

特開昭55-128816(2)

下する空孔径2μm未満の空孔の比率を極力小さくし有効に作用する2μm以上の空孔をより多く有するコンデンサ素子を造り、使用することの肝要であり、本発明の主旨もここにある。発明者の実験によれば形状が扁平状のもの70%、球形状30%からなるタンタル粉粒1.6gを5μの坩堝で成形し真空度 10^{-5} Torr、温度1600°C中で30分間加熱して焼結したコンデンサ素子の有する全空隙率(以下累積空隙率)と空隙率を形成する空孔の径1図述のように必ずしも径ではなくタンタル粒間の隙隙と考える)を焼結後のコンデンサ素子の密度毎に示したのが図2図である。この場合の累積空隙率とはコンデンサ素子の容積に対する空隙の割合を示し、密度とは単位 g/cm^3 で表わし $1cm^3$ 中のタンタル粉末の重量で表わした。なお第2図中に示した符号、数字は下記の場合を表わしたものである。○は0~1μm未満の空孔径が有する空隙を、△は2~3μm未満、△は3~4μm未満を表わし、数字は前記の

(6)

以上述べたように扁平状70%球形状30%からなるタンタル粉粒を焼結して得たコンデンサ素子では累積空隙率に占める2μm以上の空孔の比率が本発明1~4では0.68~0.89と高く、空孔を有効に利用して静電容量を増大させることができる。本発明3および4において累積空隙率が32%および22%と低いが、これらは第1図に示す比率が0.81および0.89と高い。第2図および第1図に示したのはいずれもタンタル粉粒を一定量成形し焼結した場合、すなわち単位重量当りについて述べたものであるからタンタル粉粒量を増量して相対的に静電容量を増した場合でも比率は変わらないので空孔を有効に利用できる。そして一般に焼結したタンタル固体電解コンデンサではコンデンサ素子の密度が低い場合静電容量は大であるが漏れ電流、耐電圧は密度が高いコンデンサ素子に比較して劣り密度が高い場合には漏れ電流、耐電圧特性は良好だが静電容量が小となるから、前記比率を考慮しながら静電容量、漏れ電流、耐電圧を適宜に設定することができるとができる。

(6)

実施例 2

タンタル粉粒の形状が小さな球形状の集まりから、なつて1個の粉粒を形成した凝集粒を主としたものからなる場合の実施例について述べる。この凝集粒を用いたコンデンサ素子は耐電圧が高く漏れ電流が少ない特徴を有している。この凝集粒が形成するタンタル粉粒1.0gを実施例1と同様5μの金箔で包み真空度 10^{-5} Torr、温度1600℃中で30分間加熱して焼結したコンデンサ素子の空隙率と凝集空隙率との関係を焼結後のコンデンサ素子の密度毎に第3図に示した。なお符号、数字は実施例1の場合の第2図と同様である。この実施例においてコンデンサ素子は密度 8g/cm^3 の場合焼結後における反りや割くずれなどの変形を生じて使用に耐えず、また密度 10g/cm^3 では凝集空隙率が小さくなるほか内部に空洞のように形成される外部と導通しない空隙、すなわち半導体層形成の全く含浸されない空隙も存在する。第3図に示した静電容量に特に有効に作用する2μm以上の空隙が凝集空隙率に占める比率を第2表に示す。

(7)

固体電解コンデンサではコンデンサ素子の密度が高い場合には静電容量は大であるが漏れ電流、耐電圧は密度が高いものに比較して劣り、密度が高い場合にはこれと逆の特性を示す。実施例1および2で述べたのはいずれもタンタル粉粒を一定量包み出した場合、すなわち単位重量当たりについて述べたものであるから前記の各特性を考慮してタンタル粉粒量を増減すれば静電容量、漏れ電流、耐電圧特性を制御したコンデンサを得ることのできるし、また単位重量当たりの凝集空隙率が小さくても粉粒を増加すれば相対的には凝集空隙率および2μm以上の空隙を増すことのできる。本発明はこの凝集空隙率に対する2μm以上の空隙の比率を高いコンデンサ素子を得ることに着目し、実施例1および2の結果からこの比率を0.68以上としたものであり密度 10g/cm^3 の場合には凝集空隙率が15%前後で、かつ比率も0.5および0.55と極端に低下するため、前記した静電容量、漏れ電流、耐電圧などの特性を適切にできる程に小さいのでこれを除外したものである。

(8)

第 2 表

	密度(g/cm^3)	凝集空隙率	2μm以上の空隙の比率	比率
本発明5	7	49	39	0.79
6	8	36	31	0.86
7	9	27	24	0.89
実施例2	10	17	8	0.53

この実施例2において密度 8g/cm^3 の場合は前述のように焼結時における変形のために使用できずまた 10g/cm^3 の場合は静電容量に有効に作用する空隙の比率が極端に低下し使用できない。

以上述べたように実施例1および実施例2ではタンタル粉粒の形状により焼結時の変形を生ずる密度は異なるが、第1表および第2表から明らかに凝集空隙率中に占める2μm以上の空隙の比率はいずれの場合も密度 10g/cm^3 において急激に低下を示す。第1表および第2表において本発明1~7は凝集空隙率にかなりのバラツキを有するものの、凝集空隙率中に占める2μm以上の空隙の比率は0.68以上であり高い値を示している。そして前にも述べたとおり一般に焼結形タンタル

(9)

4. 図面の簡単な説明

第1図は焼結後の空隙率と空隙孔から得られた静電容量の比との関係を示す特性図、第2図は扁平粒を主としたタンタル粉粒を焼結した本発明のコンデンサ素子が有する凝集空隙率と凝集空隙を形成する空隙の径とを密度毎に示した特性図、第3図は凝集粒を焼結した本発明のコンデンサ素子が有する凝集空隙率と凝集空隙を形成する空隙の径とを密度毎に示した特性図である。

特 許 出 願 人

マルコン電子株式会社

(10)

